

2Т368Б

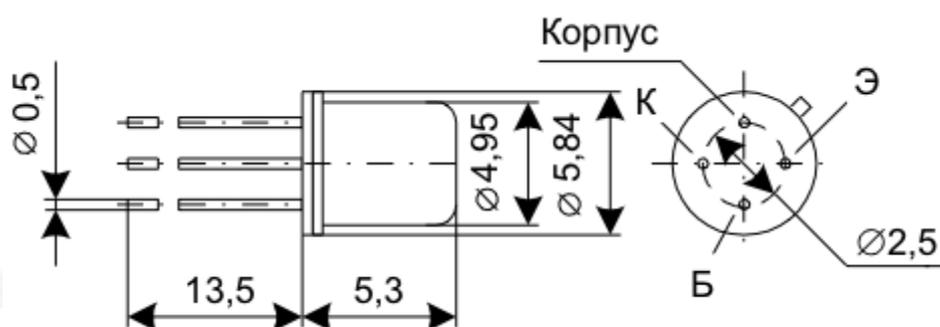
Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры n-p-n усилительные. Предназначены для использования во входных и последующих каскадах усилителей высокой частоты. Выпускаются в металлоглазном корпусе с гибкими выводами.

Масса транзистора в металлоглазном корпусе не более 1 г.

Тип корпуса: КТ-1-12.

Технические условия: СБ0.336.051 ТУ.

Изготовитель - АО «Светлана», Санкт-Петербург.



Основные технические характеристики транзистора 2Т368Б:

- $h_{21э}$ - Статический коэффициент передачи тока транзистора для схем с общим эмиттером: 50... 300;
- $f_{гр}$ - Граничная частота коэффициента передачи тока транзистора для схемы с общим эмиттером: не менее 900 МГц;
- $I_{кбо}$ - Обратный ток коллектора при $U_{кб} = 15$ В: не более 0,5 мкА;
- $C_{к}$ - Емкость коллекторного перехода: не более 1,7 пФ;
- $U_{кб}$ и $U_{кэг\max}$ - Максимальное напряжение коллектор-база и коллектор-эмиттер при $R_{бэ} = 3$ кОм: 15 В;
- $U_{эб\max}$ - Максимальное напряжение эмиттер-база: 4 В;
- $I_{к\max}$ - Максимально допустимый постоянный ток коллектора: 30 мА;
- $I_{к\text{ и }I_{к\max}}$ - Максимально допустимый импульсный ток коллектора: 60 мА;
- $P_{к\max}$ - Постоянная рассеиваемая мощность коллектора: не более 225 мВт.